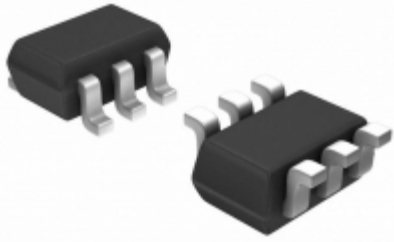


	<p>SI1912EDH-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1912EDH-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.13A SC70-6</p>
	<p>Datenblätter:  SI1912EDH-T1-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 67865 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI1912EDH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.13A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	67865 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.13A 570mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	570mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.13A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 1.13A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 100µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1912
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1912EDH-T1-E3TR

SI1912EDH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1912EDH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1912EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1912EDH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1906DL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-323</p>	 <p>SI19134CTU SILICON SI19134CTU SILICON</p>	 <p>SI1906DL-T1(PCH0) VISHAY SI1906DL-T1(PCH0) VISHAY</p>	 <p>SI1912EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.13A SC70-6</p>
 <p>SI1913DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p>	 <p>SI1912EDH-T1 VISHAY SI1912EDH-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1906DV-T1 VISHAY VISHAY SOT-363</p>	 <p>SI1912EDH-T1-GE3 VISHAY SI1912EDH-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊛ SI1902DL-T1-E1 | ↔ SI1902DL-T1-E3 | ⇒ SI1902DL-T1-E3 | D SI1902DL-T1-GE3 | ⇒ SI1902DL-T1-GE3 |
| ⊣ SI1903DL | ⊛ SI1903DL-T1 | D SI1903DL-T1-E3 | ⇒ SI1903DL-T1-E3 | ⇒ SI1903DL-T1-GE3 |
| ⊛ SI1903DL-T1-GE3 | ⊣ SI1904EDH-T1 | ⊛ SI1904EDH-T1-GE3 | ↔ SI1905BDH-T1-E3 | ⇒ SI1905BDH-T1-E3 |
| D SI1905BDH-T1-GE3 | ⊛ SI1905BDH-T1-E3 | ⊣ SI1905DL | ⊛ SI1905DL-T1 | ⇒ SI1905DL-T1-E3 |
| ⇒ SI1905DL-T1-E3 | ↔ SI1905DL-T1-GE3 | ⊛ SI1906DL-T1 | ⊣ SI1912EDH | ⇒ SI1912EDH-T1 |
| ↔ SI1912EDH-T1-E3 | ⇒ SI1912EDH-T1-GE3 | D SI1913DH-T1-E3 | ⊛ SI1913DH-T1-E3 | ⊣ SI1913DH-T1-GE3 |
| ⊛ SI1913EDH-T1 | D SI1913EDH-T1-E3 | ⇒ SI1913EDH-T1-E3 | ↔ SI1913EDH-T1-GE3 | ⇒ SI1917EDH-T1 |
| ⊣ SI1917EDH-T1-E3 | ⊛ SI1917EDH-T1-E3 | ↔ SI1917EDH-T1-GE3 | ⇒ SI1922EDH-T1-GE3 | ⇒ SI1922EDH-T1-GE3 |
| ⊛ SI1926DL-T1-E3 | ⊣ SI1926DL-T1-E3 | ⊛ SI1926DL-T1-GE3 | D SI1926DL-T1-GE3 | ⇒ SI1958DH-T1-E3 |
| ↔ SI1958DH-T1-E3 | ⊛ SI1965DH-E3 | ⊣ SI1965DH-T1-E3 | ⊛ SI1965DH-T1-E3 | ⇒ SI1965DH-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited